

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание						
								*)		РЕУН.468332.001 СБ 2D	Сборочный чертеж		*) ЛД, А4
								*)		РЕУН.468332.001 ЭЗ 2D	Схема электрическая принципиальная		*) ЛД, А4
Справ. N	*)		РЕУН.468332.001 ПЭЗ ТЭ	Перечень элементов		*) ЛД, А4							
	*)		РЕУН.468332.001 ВП ТЭ	Ведомость покупных изделий		*) ЛД, А4							
				Сборочные единицы									
	*)	2	РЕУН.687253.002 ТЭ	Плата печатная	1	*) ЛД, А4							
Попр. и дата	A3		4	РЕУН.752699.001 ТЭ	Радиатор	1							
					Стандартные изделия								
			6		Винт с цилиндрической головкой DIN 84-M3x6-4.8	4							
			8		Шайба плоская DIN 125- 3-300HV	4							
Инв. N подл.	Разраб.	Подлестный	подп.	08.06.23	Плата термостабилизации	Лит.	Лист	Листов					
	Пров.	Шавликов	подп.	08.06.23			1	10					
	Н. контр.	Мирошников	подп.	08.06.23									
	Утв.	Шавликов	подп.	08.06.23									

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Прочие изделия		
				Конденсаторы фирма Kemet, США		
		11		C1206C106K3PACTU	1	C7
		13		C1210C475K5PACTU	3	C11, C13, C15
		15		C1210C476M4PACTU	2	C28, C29
		17		Конденсатор GRM21BR71H105KA12L фирма Murata, Япония	1	C16
				Конденсаторы фирма JВ Capacitors, Тайвань		
		20		JCK1A221M063077	1	C30
		22		JCK1H101M100105	1	C10
						Лист
						2
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

РЕУН.468332.001 ТЭ

Инв. N подл.	Подп. и дата		Взам. инв. N	Инв. N дубл.		Подп. и дата							
Изм.	Подп.		Лист	Дата		Лист							
Инв. N подл.				Подп. и дата									

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		43		Не устанавливать	1	C27, C34
		45		Микросхема INA199A1DCKT	1	DA4
				фирма Texas Instruments, США		
		47		Микросхема K7805-500R3	1	DA1
				фирма Mornsun Power, Кумау		
		49		Микросхема LT3741EFE # PBF	1	DA3
				фирма Analog Devices, США		
				Микросхема фирма Texas Instruments, США		
		52		Микросхема LMV321IDBVT	4	DA5-DA8
		54		Микросхема TLV70233DBVT	1	DA2
		56		Микросхема MAX232ID	1	DD2
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468332.001 ТЭ	
					Лист 4	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		59		Микроконтроллер STM32F030C8T6	1	DD1
				фирма ST Microelectronics, Малайзия		
				Светодиоды фирма Kingbright, Тайвань		
		62		APT1608CGCK	1	HL1
		64		APT1608EC	1	HL2
		66		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	L1
				фирма Murata Electronics, США		
		68		Катушка индуктивности	1	L2
				IHLP5050FDER4R7M01		
				фирма Vishay, США		
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		71		RC0603FR-070RL	4	R16,R33,
						R34,R46
		73		RC0603FR-0710RL	2	R17,R18
						Лист
						5
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

РЕУН.468332.001 ТЭ

Копировал

Формат А4

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		75		RC0603FR-071KL	4	R3,R5,R38,
						R39
		77		RC0603FR-074K7L	1	R47
		79		RC0603FR-0710KL	11	R1,R2,R21,
						R35-R37,
						R40-R43,
						R45
		81		RC0603FR-0711KL	1	R19
		83		RC0603FR-0712KL	2	R25,R27
		85		RC0603FR-0747KL	2	R11,R15
		87		RC0603FR-0775KL	1	R9
		89		RC0603FR-0782KL	1	R14
						Лист
						6
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

РЕУН.468332.001 ТЭ

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
		92		RC0603FR-07100KL	7	R4,R6,R10,
						R13,R29,
						R30,R44
		94		RC0603FR-07120KL	1	R8
		96		Резистор WSLP25125L000JEA	2	R23,R24
				фирма Vishay, США		
		98		Потенциометр 3224W-1-104E	1	R28
				фирма Bourns, США		
		100		Не устанавливать	7	R7,R12,R20,
						R22,R26,
						R31,R32
		102		Стабилитрон BZX384-C12	2	VD3,VD7
				фирма Nexperia, Нидерланды		
		104		Диод PMEG6010CEH	3	VD2,VD4,
				фирма NXP Semiconductors, Кумай		VD8
РЕУН.468332.001 ТЭ						Лист
						7
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		107		Диод SM05T1G	1	VD6
				фирма ON Semiconductor, США		
		109		Диод SMAJ36CAHE3/61	1	VD1
				фирма Vishay, США		
		111		Не устанавливать	1	VD5
		113		Транзистор 2N7002K	6	VT1, VT5, VT6,
				фирма ON Semiconductor, США		VT8–VT10
		114		Транзистор IRFR5305TRPBF	2	VT2, VT7
				Infineon Technologies, Германия		
		116		Транзистор WMB032N04LG2	2	VT3, VT4
				фирма Wapop, Китай		
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	РЕУН.468332.001 ТЭ	
					Лист	
					8	

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	126	Клемма 1725656	3	X5-X7
						фирма Phoenix Contact, Германия		
Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	128	Клемма PCB7M3	4	X1-X4
						фирма Yuansichuang, Китай		
Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	129	Компаунд КПТД-1/1Т-5.5	25	г
						фирма Номакон		
Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата		Материалы		
Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата		Комплекты		
Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата	643.РЕУН.00002-01	Программное обеспечение		
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	РЕУН.468332.001 ТЭ			
					Лист 9			

Лист регистрации изменений

[illegible]

инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PEYH.468332.001 ТЭ

Лист

10